

## SF216

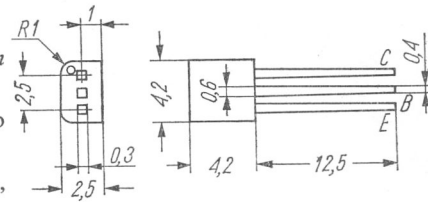
Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny *n-p-n* w obudowie plastikowej, ciężar około 0,1 G

Zastosowanie: wzmacniacze i oscylatory w.cz. do 100 MHz

Typy podobne: BF121 (ITT), TIS62÷64, (Tex), MPS6569, MPS 6568 (Mot), BF195, BF255 (Tel, Sic, Ph)



Rys. 1-965. SF216

### Wartości charakterystyczne<sup>1)</sup>

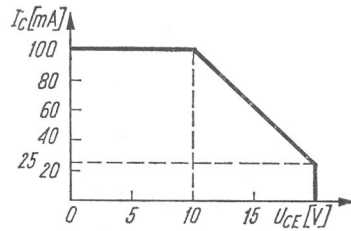
	min	typ	max		
$I_{CBO}$		5	100	nA	przy $U_{CB} = 20$ V
$I_{CBO}$			10	$\mu$ A	przy $U_{CB} = 40$ V
$U_{(BR)EBO}$			5,9	V	przy $I_E = 10$ $\mu$ A
$U_{(BR)CEO}$	20			V	przy $I_C = 10$ mA
$h_{21E}$ (B)	28		71		przy $U_{CE} = 6$ V, $I_C = 2$ mA, $f = 1$ kHz
(C)	56		140		
(D)	112		280		
(E)	224		560		
$f_T$	100	400		MHz	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz
$F$		8		dB	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz, $R_g = 60$ $\Omega$
$\frac{ h_{12b} }{\omega}$		80		ps	przy $U_{CB} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 30$ MHz
$-C_{12e}$		2,3		pF	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 500$ kHz
$C_{22b}$		3,5	4,3	pF	przy $U_{CE} = 10$ V, $f = 20$ MHz, $I_E = 0$
$G_D$		4	5,2	dB	przy $U_{CE} = 8$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 100$ MHz, $R_g = 60$ $\Omega$ $R_L = 1$ k $\Omega$
Parametry $y$ w układzie OE					
$y_{11e}$		6,8+j7,35		mS	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz
$y_{12e}$		-0,1-j1,6		mS	
$y_{21e}$		23,5-j39,5		mS	
$y_{22}$		1,65+j2,75		mS	
$y_{11e}$		4,3+j5,2		mS	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 50$ MHz
$y_{12e}$		-0,08-j0,9		mS	
$y_{21e}$		34,5-j44,5		mS	
$y_{22}$		1,35+j1,75		mS	
$y_{11e}$		1,4+j1,55		mS	przy $U_{EC} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 10,7$ MHz
$y_{21e}$		74,0-j43		mS	
$y_{22}$		0,5+j0,89		mS	
Parametry $y$ w układzie OB					
$y_{11b}$		31,5-j31		mS	przy $U_{CB} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 100$ MHz
$y_{12b}$		1,56-j1,17		mS	
$y_{21b}$		-25+j36,5		mS	
$y_{22}$		1,65+j2,75		mS	

$Y_{11b}$	$40,5 - j37,5$	mS	} przy $U_{CB} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 50$ MHz
$Y_{12b}$	$-1,45 - j0,95$	mS	
$Y_{21b}$	$-38,5 + j43$	mS	
$Y_{22}$	$1,35 + j1,75$	mS	
$Y_{11b}$	$84 - j37,5$	mS	} przy $U_{CB} = 10$ V, $I_C = 5$ mA, $f = 10,7$ MHz
$Y_{21b}$	$-85 + j37,5$	mS	
$Y_{22}$	$0,5 + j0,89$	mS	
$f_{max}$	430	MHz	przy $U_{CE} = 19$ V, $I_C = 5$ mA

## Wartości graniczne

$U_{CBO\ max}$	40	V	$P_{tot\ max}$	200	mW
$U_{CEO\ max}$	20	V	$t_j\ max$	+125	°C
$U_{EBO\ max}$	5	V	$t_{amb}$	-40 ÷ +100	°C
$I_C\ max$	100	mA	$R_{th\ j-a}$	0,5	°C/mW
$I_B\ max$	10	mA			

1)  $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$  ( $-5^\circ\text{C}$ )



Rys. 1-966. Dopuszczalny zakres pracy